	13	формат	Зона	Паз.	Обозна ченив	<u>o</u>		Наименован	ue	Кол.	Приме- чание
примен.	PEYH. 94 16 13.002	*)			РЕУН.468323.001 СБ 2D			<u>Документация</u> Сборочный чертеж	<u>1</u>		*/ЛД,А2
Перв. г	PEYH!	*/			PEYH.468323.001 33 2D		Схема электрическая принципиальная				*/ЛД,АЗ,А4
		*/	РЕУН.468323.001 ПЭЗ ТЭ					Перечень элементов			*/ЛД,А4
		*/			РЕУН.468323.001 ВП ТЭ			Ведомость покупных и	зделий		*/A3,A4
Справ. И								Сборочные едини	<u>ІЦЫ</u>		
		*/		2	PEYH.687253.003 T3			Плата печатная		1	*/ЛД,А4
								Прочие издели	<u>19</u>		
Подп. и дата				5				Резонатор ABSO7-120-32 фирма Abracon, США	. 768KHZ-T	1	BQ1
Инв. И дубл.				7				Резонатор NX2520SA-16MHZ Фирма NDK, Япония	'-STD-CSW-5	1	BQ2
Взам. инв. И											
Подп. и дата		Ma:	71	<u> </u>	N down Todo To-			PEYH.46832	23.001		7
Инв. Иподл.		Пр Н.к	//ис град гов. онт тв.	Б. Г/ <u> </u> Д.	N докум. Подп. Дата Подлесный подп. 10.06.22 Иавликов подп. 10.06.22 Иавликов подп. 10.06.22			лата авления	<i>Лит.</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>/lucm</u> 1	Листов 10

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Kon	Приме- чание
			9		Конденсатор GRM21BR60J226ME39L	1	<i>C2</i> 4
					фирма Murata Manufacturing, Япония		
					Конденсаторы фирма Үадео, Тайвань		
			12		CC0603JRNP09BN120	4	<i>C1,C2,C5,C6</i>
			14		CC0603KPX7R9BB103	6	C25,C26,C2
							C30,C51,C52
			16		CC0603KRX7R9BB333	1	C21
Подп. и дата			18		CC0603MRX5R7BB105	16	C19,C33-C4
Инв. N дубл.			20		CC0603ZRY5V9BB104	24	C3,C4,C7-C C14,C16,C17,
Взам. инв. N							C20,C22,C2 C27,C28,C. C32,C48-C5
							C53-C55
Подп. и дата							
Инв.N подл.					DEUIT/0707001 T		Лис
NH.	Изм	1. //	ист	N°докум. Подп. Дата К	PEYH.468323.001 Т. Гопировал Формал		2

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Конденсаторы фирма Үадео, Тайвань		
	Н						
			23		CC0805KKX7R7BB475	1	<u>C13</u>
			<i>25</i>		CC1206KKX5R8BB106	2	<u>C15,C18</u>
			<i>2</i> 7		Микросхема K7805-500R3	1	DA2
					фирма Mornsun Power, Китай		
			29		Микросхема LM2904DR2G фирма ON Semiconductor, США	2	DA5,DA6
Подп. и дата					фирма ST Microelectronics, Швейцария		
Инв. И дубл.			32		Микросхема L 7805CV-DG	1	DA1
Взам. инв. N			34		Микросхема TS4962IQT	1	DA4
Взам.			36		Микросхема TLV70233DBVT	1	DA3
Подп. и дата					фирма Texas Instruments, США		
\mathbb{H}	<u> </u>		<i>38</i>		Микросхема CP2102N-A02-GQFN20R фирма Silicon Labs, США	1	DD3
Инв.N подл.	Изм	1. /IU	יכוח	N°докум. Подп. Дата	РЕУН.468323.001 ТЭ Копировал Формат		Лисп 3

	Формат	Зона	Поз.	Обозначен	ue	Наименование	Кол	Приме- чание
	\blacksquare	- 4	40			Микросхема MAX232ID	3	DD4-DD6
						фирма Texas Instruments, США		
						Микросхемы фирма Microchip Technology, США		
		4	43			MCP4011-502E/MS	1	DD2
			 45			24LC04B/SN	1	DD7
						Z4LCU4D/ 3N		
יום		4	47			Микроконтроллер STM32F401RET6	1	DD1
Подп. и дата						фирма ST Microelectronics, Швейцария		
λδη.			49			Предохранитель MF-SMDF050-2	1	FU1
Инв. N дубл.						фирма Bourns, США		
Взам. инв. N						Светодиоды фирма Kingbright,Тайвань		
	\prod		<i>52</i>			APT1608CGCK	1	HL1
Подп. и дата		$\frac{1}{1}$	<i>J</i> <u></u>			AT TIUUULULN	1	I IL I
Подп	\mathbb{H}	\dashv	54			APT1608EC	4	HL2-HL5
Инв.N подл.			<u> </u>					/luc
NHO.N	Изм	Лис	TITI	№докум. Подп	Дата РЕ Копировал	ЧН.468323.001 ТЭ Форма		4

	формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
	_						
		_	56		Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D	1	L1
		-			фирма Murata, Япония		
	-	-					
					Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
			59		RC0603FR-070RL	12	R9,R14,R15
							R24,R25,R4
							R46,R50,R5
							R62,R64,
							R66
<u> </u>	_						
дата			61		RC0603FR-0710RL	2	R38,R39
Nodn. u	_		63		RC0603FR-0722RL	4	R48,R49,R5
. "	╁				NEGOGS/N G/ZZNZ	<u>, </u>	R57
Инв. N дубл.							
+	╁		65		RC0603FR-071KL	8	R10,R17-R
≥							R42,R47,R5
Взам. инв. N							R60
ата							
Подп. и дата			67		RC0603FR-071K5L	2	R51,R61
	 						
Инв. И подл.					PEYH.468323.001 T3	—— }	1 /lui
_	Изі	4. /IU	ст	№докум. Подп. Дата Ко.	пировал Формат		

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
			70		RC0603FR-074K7L	4	R20,R21,
							R56,R58
			70		DC04075D_0740W	24	D7.0 4.044
			72		RC0603FR-0710KL	21	R3,R6,R11,
						+	R16,R26,
							R29-R31,
							R34-R37,R4 R43,R63,R6
							R67-R71
							NOT NT
	_		74		RC0603FR-0720KL	4	DZ2 DZZ D/
	╁		/4		KLUDUJFK-U7ZUKL	4	R32,R33,R4 R44
дата							K44
Подп. и д							
Под			76		RC0603FR-0722KL	1	R54
удл.	_						
И дубл.							
NHB.	_		78		RC0603FR-0727KL	2	R27,R28
HÔ. N							
Взам. инв. N			80		RC0603FR-0747KL	1	R53
	$ begin{array}{c} - \end{array}$	Н					
ı damı							
Подп. и дата			_				
_							
Инв.N подл.							/luc
Инв./	NSV	1. /lu	cm	N°докум. Подп. Дата	PEYH.468323.001 T	J	6
	1,131				ировал Форм	ıam A4	

	Формат	Зона	<i>No3.</i>	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
	H		<i>85</i>		RC0603FR-07100KL	17	R1,R2,R4,R
	H		00		INCOUDSI IN-07 IOUNE	1''	R7,R8,R12,R
							R72-R80
			87		RC0603FR-07150KL	2	R22,R23
			89		Диод MBR130LSFT1G	1	VD1
					фирма ON Semiconductor, США		
			91		Диод SMAJ15A-13-F	1	VD2
дата					фирма Diodes Incorporated, США	<u> </u>	
liodn. u c			93		Диод SM05T1G	6	VD3-VD8
.'	H				фирма ON Semiconductor, США	 	100 000
ино. N ауол.					gapina on semiconascion, cam		
IHO. N			95		Транзисторы 2N7002K	11	VT1-VT11
B3am. UHD. N	$ \cdot $				фирма ON Semiconductor, США	<u> </u>	
дата	H						
Подп. и дата	H						
ייססע							
Ино. И подл.	Изм	. /Iuu	<i>-m</i>	N°докум. Подп. Дата	PEYH.468323.001 Т_ пировал Форм	am A4	/luc

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Вилки фирма Connfly Electronic, Китай		
			100		DS1066-02MVW6	6	X1,X2,X6,
							X15-X17
			102		DS1066-03MVW6	1	X13
			104		DS1066-04MVW6	1	X3
			106			1	VE
			100		DS1069-2MVW6X	1	X5
па			108		DS1069-4MVW6X	1	X14
Подп. и дата							
No			110		Вилка L-KLS1-207C-2,50-2-10-S,	1	X4
N дубл.					фирма KLS Electronic, Китай		
Инв. И							
					Вилки фирма Molex, США		
Взам. инв. N							
<u>B</u>			113		70246-1201	1	X7
Подп. и дата							
Подп.			115		87834-0819	3	X8-X10
подл.				<u> </u>			
Инв.N подл.	Изм	1. /IU	<i>cm</i>	N°докум. Подп. Дата	РЕУН.468323.001 ТЭ Копировал Формаг		<i>fluc</i> 8

	Формат	Зона	/los.	Обознач	нение		Наименование	202	I/OV	Приме- чание
									_	
			118				Розетка 1050170001	2	_	X11,X12
							фирма Molex, США		_	
									\dashv	
									+	
									\dashv	
									1	
									1	
									1	
									\dashv	
дата										
Подп. и										
И дубл.									_	
									4	
Инв.	$oxed{oxed}$								\dashv	
>	\vdash								\dashv	
Взам. инв. N	\vdash								\dashv	
B3ar	\perp							+	\dashv	
	\vdash								\dashv	
Подп. и дата									\dashv	
odn. u									\dashv	
7									1	
Ìñ.	$ begin{array}{c} \hline \end{array}$								寸	
Инв.И подл.			\Box	<u>'</u>				71 T 7		Лист
Инв	Изм	. /Iu	cm _	N°докум. Подп.	Дата	PEYH.468323.001 T3				
						Копировал		Формат А	4	

				Лист рег	гистрации	изменений			
Изм.		лера листов заменен- ных	в (страниц) новых	анулиро- ванных	Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопрово- дительного документа и дата	Подпись	Дата
							UUIIIU		
_									
igg									
				<u> </u>					
					PF YH 4	68323 i	001 T 3		Лист
Изм.	Лист N до	кум. Поді	п. Дата	Копировал			Формат д	1.	10